94-0008

Изобретение относится к полупроводниковой технологии и может быть использовано для получения эпитаксиальных слоев фосфида индия, выращенных хлоридным способом с воспроизводными электрофизическими параметрами. Для повышения качества и воспроизводимости электрофизических параметров эпитаксиальных слоев в процессе выращивания эпитаксиальных слоев AIIIBV в хлоридной системе, включающем подготовку оснастки, химическое травление, продувку реакторов водородом, термостатирование хлорида, нагрев источника и подложек, химическое травление подложек, выращивание слоев, проводят повторное газовое травление выращенного слоя с последующим его ростом.

Технический результат изобретения заключается в повторном проведении газового травления выращенного слоя с последующим его ростом.

П. формулы: 1